

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-174975

(43)Date of publication of application : 31.07.1987

(51)Int.Cl.

H01L 29/80

H01L 29/46

H01L 29/91

(21)Application number : 61-017114

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 28.01.1986

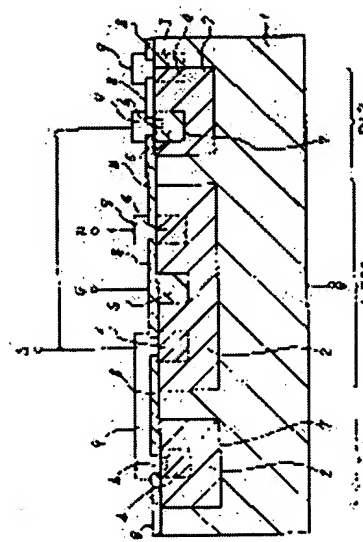
(72)Inventor : SAMEJIMA HIROYUKI
HAGIMOTO YOSHIZO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten stabilization time of an erectret capacitor microphone, by forming a silicide layer in an interconnection to a metal electrode of a P-N junction diode connected reversely and in parallel between a gate and a source of a junction-type field-effect transistor.

CONSTITUTION: In a diode section Di2, a P+ type semiconductor region 5 is formed within an N-type semiconductor region 2 surrounded by a P-type semiconductor region 1 to form a P-N junction 7. Silicide layers 6 are provided in interconnections to metal electrodes 9 in diode sections Di1 and Di2 so that strains are provided only in the diode sections by volume reduction. More particularly, strains are provided only in the diode sections by volume reduction which occurs during formation of the silicide layers, so that the life time of carriers is shortened to decrease the impedance.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-174975

⑤ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)7月31日

H 01 L 29/80
29/46
29/80
29/91C-8122-5F
A-7638-5F
Z-8122-5F
A-7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 半導体装置

⑮ 特 願 昭61-17114

⑯ 出 願 昭61(1986)1月28日

⑰ 発 明 者 鮫 島 博 之 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑱ 発 明 者 萩 本 佳 三 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

接合型電界効果トランジスタのゲートとソースとの間にp-n接合型ダイオードが逆方向で並列に接続されている半導体装置において、該p-n接合型ダイオードが電極取り出し部にシリサイド層を有することを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関し、特にエレクトレットコンデンサマイクロホン(以降ECMと呼ぶ)に使用する接合型電界効果トランジスタ(以降J-FETと呼ぶ)に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、この種のECM用J-FETは第4図に示

すような使い方をされる。第4図において、音声等がECMに入ると、ECMの振動板10が振動し、その容量変化がJ-FETのゲートGに伝えられ増幅する働きをする。このとき、J-FETの入力インピーダンスを下げてもECMの安定時間を早める必要があり、第2図に示すようにゲートGとソースSとの間にp-n接合型ダイオードDi1およびDi2が逆方向・並列に接続された構成となっていた。

すなわち、ECM用J-FETは第5図に示すように、電源V_{DD}を投入すると、ゲートGの電位V_Gは時定数τ₁でピーク値V_{Gmax}になった後、放電されて定常値V_{GO}になる。この時の時定数τ₂を安定時間と呼んでいるが、ゲートG-ソースS間にダイオードが挿入されていない場合には放電がほとんどないため、安定時間は異常に長いものとなり、ECMが安定に働くまでに長時間を要することになる。

〔発明が解決しようとする問題点〕

上述した従来のECM用J-FETはゲートG-

ソースS間に挿入されたダイオードにより、ダイオードが挿入されていない場合よりは入力インピーダンスは低くなり安定時間は短くなっているが、製品によっては、7~10秒要しており、電源投入直後は出力が歪んでしまい電話機等に使用する場合に支障があった。

p-n接合ダイオードの電流-電圧特性(V-I特性)は次式(1)のように表わされ、ゲートG-ソースS間のインピーダンスも次式(1)で決定されるダイオードが逆方向に接続されたものとして考えることができる。

$$I = qA \left(\frac{D_p}{L_p} p_n + \frac{D_n}{L_n} n_p \right) \left[\exp\left(\frac{qV}{mkT}\right) - 1 \right] \dots (1)$$

Aは接合面積、mは1~2の値をもつ定数、

D_p と D_n は正孔と電子の拡散定数、

$L_p \equiv \sqrt{D_p \tau_p}$ は正孔の拡散距離、

$L_n \equiv \sqrt{D_n \tau_n}$ は電子の拡散距離、

p_n は平衡状態におけるn領域での正孔密度 $\approx n_i^2 / N_D$ 、

もつながる。③のキャリアのライフタイムを下げることは熱歪を入れる等により比較的容易であり、従来のECM用J-FETでも安定時間改善のため熱歪を入れたものもある。しかし熱歪を入れるということは、ダイオード部だけではなくJ-FET部にも歪が入ることになり、ノイズが大きくなってしまふという欠点がある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の半導体装置は、接合型電界効果トランジスタのゲートとソースとの間にp-n接合型ダイオードが逆方向で並列に接続されている半導体装置において、このp-n接合型ダイオードが電極取り出し部にシリサイド層を有していることを特徴としている。

〔実施例〕

次に本発明について図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例の縦断面構造図である。J-FET部、Di1部、Di2部を区分して示してある。J-FET部は、P型半導体領域1により取り囲まれたn型半導体領域2内にゲート領

n_p は平衡状態におけるP領域での電子密度

$$\approx n_i^2 / N_A,$$

n_i は室温(300K)では $n_i \approx 1.5 \times 10^{10} / \text{cm}^3$ 、

N_D, N_A はドナーおよびアクセプタ濃度。

従来のECM用J-FETの安定時間がやや長いという問題は、p-n接合ダイオードのインピーダンスが高いということであり、インピーダンスを下げるには(1)式より、

① 接合面積Aを大きくする。

② p-n接合ダイオードのドナーおよびアクセプタ濃度 N_D および N_A を小さくする。

③ キャリアのライフタイム τ_p, τ_n を小さくする。

ことにより可能である。

しかしながら①の接合面積を大きくすることはコスト上不利であり、また容量も大きくなってしまふ。また②のp-n接合ダイオードのドナー、アクセプタ濃度 N_D, N_A を小さくすることは、ダイオード部とJ-FET部との製造方法を変更しなければならず、工程が複雑になり、コストupに

域となる P^+ 型半導体領域5と、ソースS及びドレインDのオーミックコンタクト領域4とが形成されている。ダイオードDi1部はp型半導体領域1により取り囲まれたn型半導体領域2内に n^+ 型オーミックコンタクト領域4が形成され、p型半導体領域1とn型半導体領域2とでpn接合部7が形成されている。ダイオードDi2部はp型半導体領域1により取り囲まれたn型半導体領域2に P^+ 型半導体領域5が形成され、n型半導体領域2と P^+ 型半導体領域5とでpn接合部7が形成されている。ダイオードDi1部、Di2部の金属電極9の取り出し部にはシリサイド層6が形成され、ダイオード部にのみ体積収縮により歪が入れられている。すなわち、シリサイド層形成の際に起こる体積収縮により、ダイオード部にのみ歪を入れ、キャリアのライフタイム τ_p, τ_n を小さくしてインピーダンスを下げた構造となっている。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、ECM用J-FET

のゲートとソースとの間に逆方向で並列に接続されている $p-n$ 接合ダイオードの金属電極取り出し部にシリサイド層を形成することにより、ダイオード部にはみ歪を入れることができるため、キャリアのライフタイム τ_p, τ_n を小さくしてインピーダンスを下げることができ、ECMの安定時間を短くすることができる。また、J-FET部に歪が入らないためにノイズも大きくなり、使いやすいECM用J-FETを得ることができるという効果がある。

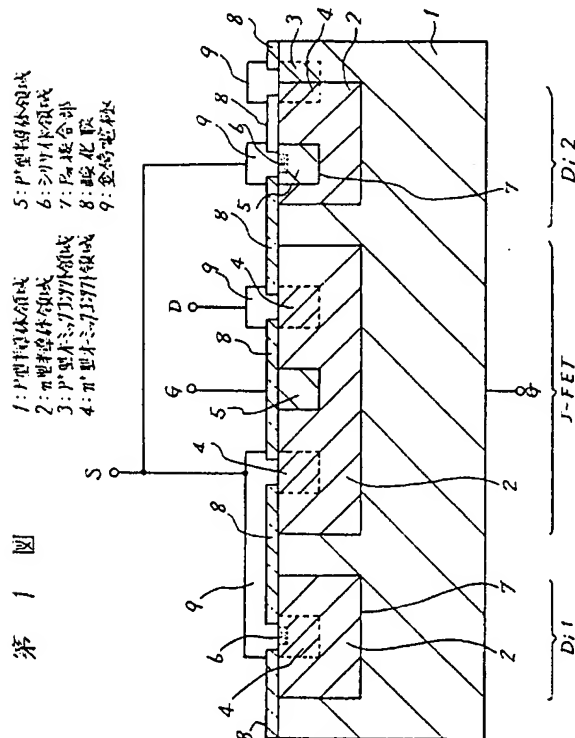
n^+ 型ホーミックコンタクト領域、5…… p^+ 型半導体領域、6……シリサイド領域、7…… $p-n$ 接合部、8……酸化膜、9……金属電極、10……振動板。

代理人 弁理士 内 原 晋

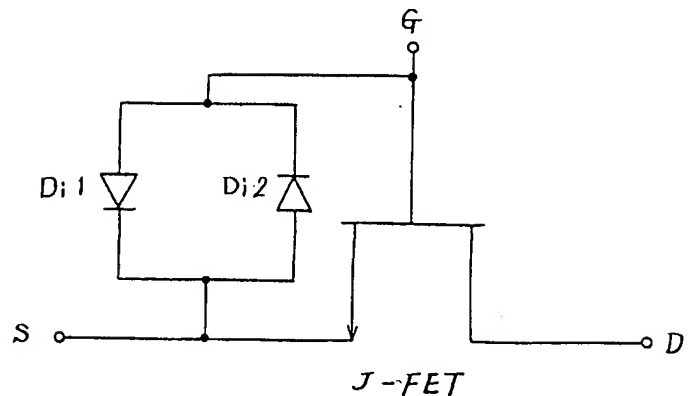
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例のECM用J-FETの縦断面構造図、第2図はECM用J-FETの等価回路図、第3図は従来のECM用J-FETの縦断面構造図、第4図はECMの構成図、第5図はゲート電圧 V_G の安定時間を説明するためのグラフである。

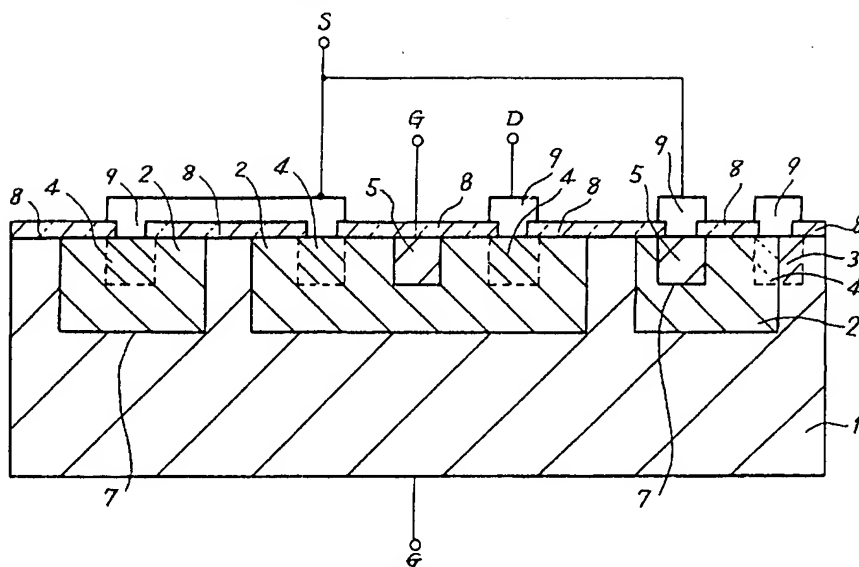
1…… p 型半導体領域、2…… n 型半導体領域、3…… p^+ 型ホーミックコンタクト領域、4……



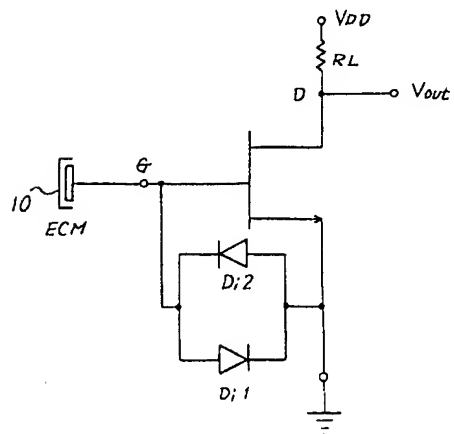
第2図



第 3 回



第 4 圖



第 5 圖

